









	<p>SI5401DC-T1-E3</p> <p>Hersteller-Teilenummer: SI5401DC-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 5.2A 1206-8</p> <p>Datenblätter:  SI5401DC-T1-E3.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI5401DC-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 5.2A 1206-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	1206-8 ChipFET™
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	32 mOhm @ 5.2A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.3W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SMD, Flat Lead
Andere Namen	SI5401DC-T1-E3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 4.5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 5.2A (Ta) 1.3W (Ta) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.2A (Ta)

SI5401DC-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5401DC-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5401DC-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SI5401DC-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI54-4R7PF CARIS SI54-4R7PF CARIS</p>	 <p>SI5401DC-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 5.2A 1206-8</p>	 <p>SI5402BDC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 4.9A 1206-8</p>	 <p>SI5397M-A-GM Energy Micro (Silicon Labs) QUAD PLL JITTER ATTENUATOR WITH</p>
 <p>SI54-100PF CARIS SI54-100PF CARIS</p>	 <p>SI5402BDC-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 4.9A 1206-8</p>	 <p>SI5402BDC-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 4.9A 1206-8</p>	 <p>SI5401DC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 5.2A 1206-8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI5401DC-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI5401DC-T1-E3 Datenblatt	SI5401DC-T1-E3-Datenblätter	SI5401DC-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI5401DC-T1-E3
SI5401DC-T1-E3 Electronic	SI5401DC-T1-E3-Komponenten	SI5401DC-T1-E3-Verteiler	SI5401DC-T1-E3-Bild	SI5401DC-T1-E3-Teil
SI5401DC-T1-E3 Preis	SI5401DC-T1-E3 Hersteller	SI5401DC-T1-E3 Bild	SI5401DC-T1-E3 Aktie	SI5401DC-T1-E3 Inventar
SI5401DC-T1-E3 Neu	SI5401DC-T1-E3 Original	SI5401DC-T1-E3 garantiert	SI5401DC-T1-E3 RFQ	SI5401DC-T1-E3 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited